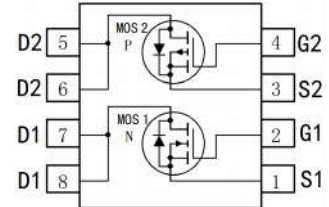
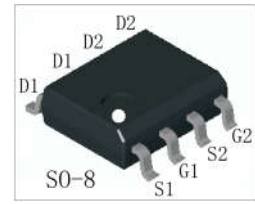


LYNPM7319SP (进口芯片) 型 N/P 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: S0-8
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好
- MOS1: N 沟道 (6.5A; 30V; 29mΩ)
- MOS2: P 沟道 (-4.9A; -30V; 58mΩ)
- 产品为非国产化



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : -55°C ~ 150°C
- 工作温度 T_{amb} : -55°C ~ 125°C
- 焊接温度不超过 260°C, 焊接时间不超过 10 秒

类型	额定功率 P_b (W)	额定功率 P_b (W)	漏源击穿电压 BV_{DSS} (V)	栅源击穿电压 BV_{GSS} (V)	漏极电流 I_{DM} (A)	导通电阻 R_{DS} (mΩ)	热阻 $R_{th(j-A)}$ (°C/W)
MOS1 (N)	1 (单芯)	2 (双芯)	30	±20	6.5	29	62.5
MOS2 (P)	1 (单芯)		-30	±20	-4.9	58	

主要电特性 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	沟道类型	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$ $V_{GS}=0V, I_D=-250\mu A$	MOS1 (N) MOS2 (P)	30 -30	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V$ $V_{DS}=-24V, V_{GS}=0V$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	1 -1	μA
		$V_{DS}=24V, V_{GS}=0V, T_j=55^\circ C$ $V_{DS}=-24V, V_{GS}=0V, T_j=55^\circ C$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	25 -25	μA
栅极漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$ $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	±100 ±100	nA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$ $V_{DS}=V_{GS}, I_D=-250\mu A$	MOS1 (N) MOS2 (P)	1 -1	—	3 -3	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.8A$ $V_{GS}=-10V, I_D=-4.9A$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	29 58	mΩ
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=4.5V, I_D=4.7A$ $V_{GS}=-4.5V, I_D=-3.6A$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	46 98	mΩ
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=15V, I_D=5.8A$ $V_{DS}=-15V, I_D=-4.9A$	MOS1 (N) MOS2 (P)	7 3	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$ $V_{DS}=-25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	650 710	—	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$ $V_{DS}=-25V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	320 380	—	pF

S0-8 封装尺寸图:

